

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005 年 9 月 1 日 (01.09.2005)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/081061 A1

(51) 国際特許分類<sup>7</sup>: G03F 7/004, 7/038, 7/039

川崎市中原区中丸子 150 番地 東京応化工業株式会社内 Kanagawa (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/001392

(22) 国際出願日: 2005 年 2 月 1 日 (01.02.2005)

(74) 代理人: 酒井 宏明 (SAKAI, Hiroaki); 〒1000013 東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 6 号 東京倶楽部ビルディング 酒井国際特許事務所 Tokyo (JP).

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:  
特願2004-043692 2004 年 2 月 19 日 (19.02.2004) JP

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東京応化工業株式会社 (TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.) [JP/JP]; 〒2110012 神奈川県川崎市中原区中丸子 150 番地 Kanagawa (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 緒方 寿幸 (OGATA, Toshiyuki) [JP/JP]; 〒2110012 神奈川県川崎市中原区中丸子 150 番地 東京応化工業株式会社内 Kanagawa (JP). 北條 卓馬 (HOJO, Takuma) [JP/JP]; 〒2110012 神奈川県川崎市中原区中丸子 150 番地 東京応化工業株式会社内 Kanagawa (JP). 辻 裕光 (TSUJI, Hiromitsu) [JP/JP]; 〒2110012 神奈川県川崎市中原区中丸子 150 番地 東京応化工業株式会社内 Kanagawa (JP). 廣崎 貴子 (HIROSAKI, Takako) [JP/JP]; 〒2110012 神奈川県川崎市中原区中丸子 150 番地 東京応化工業株式会社内 Kanagawa (JP). 佐藤 充 (SATO, Mitsuru) [JP/JP]; 〒2110012 神奈川県

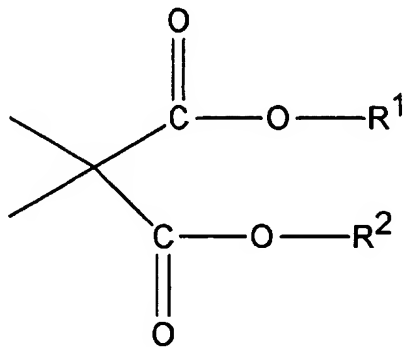
(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:  
— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: PHOTORESIST COMPOSITION AND METHOD OF FORMING RESIST PATTERN

(54) 発明の名称: フォトレジスト組成物およびレジストパターン形成方法



(1)

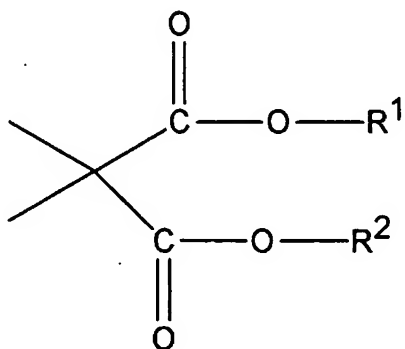
(57) Abstract: A photoresist composition which contains a fullerene derivative (A) having two or more malonic ester residues. The malonic ester residues preferably are groups represented by the following general formula (1): [Chemical formula 1] wherein R<sup>1</sup> and R<sup>2</sup> may be the same or different and each independently is alkyl. The alkyl preferably is one selected among C<sub>1-10</sub> linear, branched, and cyclic alkyls. Symbol n preferably is an integer of 2 to 10.



(57) 要約:

2つ以上のマロン酸エステル残基を有するフラレン誘導体(A)を含有させてフォトレジスト組成物を構成する。前記マロン酸エステル残基としては、下記一般式(1)

【化1】



(1)

(式中、 $R^1$ および $R^2$ はそれぞれ独立してアルキル基であり、それぞれ同一でも異なってもよい。)で表される基が好ましい。前記アルキル基は、炭素数1〜10の鎖状、分岐状及び環状の中から選択されるいずれか1種のアルキル基であり、 $n$ が2〜10の整数であることが好ましい。